| 東京 | 工業高等 | 専門学校 | 開講年度 令和02年度 (2 | .020年度) | 授業科目 | | |
|---|--------------|---------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 科目基礎 | | | | • | | | |
| 科目番号 | | 0131 | | 科目区分 | 専門/選択 | ₹ | |
| 授業形態 | | | | 単位の種別と単位 | 数 学修単位: | 2 | |
| 開設学科 | | 機械工学 | 科 | 対象学年 | 4 | | |
| 開設期 | | 後期 | | 週時間数 | 2 | | |
| | | | 「基礎電子工学」 | | | | |
| 担当教員 | | 水戸 慎- | -郎 | | | | |
| 到達目標 | 票 | | | | | | |
| 固体中に | こおける電子 | 子の古典的振 | る舞いについて理解している. る舞いについて理解している. ついて基礎的なことを理解している. | | | | |
| ルーブリ | ノック | | | | | | |
| | | | 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | | 未到達レベルの目安 | |
| 評価項目1 電磁界中の電子 | | | 電磁界中における電子の振る舞いを理解している. | 電磁界中における電子の振る舞い を概ね理解している. | | 電磁界中における電子の振る舞いを理解していない. | |
| 評価項目2 固体中の電子 | | | 固体中における電子の取り扱いを 理解している. | 固体中における電子の取り扱いを 概ね理解している. | | 固体中における電子の取り扱いを 理解していない. | |
| 評価項目3 p-n接合 | | | p-n接合の整流作用を理解している | いる. | | i۱. | |
| 評価項目4 バイポーラトランジスタ | | | バイポーラトランジスタの動作を 理解している. | バイポーラトランジスタの動作を 概ね理解している. | | バイポーラトランジスタの動作を 理解していない. | |
| 評価項目4 MOSFET | 1 | | MOSFETの動作を理解している. | MOSFETの動作を概ね理解している. | | MOSFETの動作を理解していない | |
| | | 頁目との関 | | ا م. | | 1. | |
| <u>チ付のま</u> 教育方法 | | スロムツ沃 | 1 Nk | | | | |
| 20世紀後 ⁴ 一方で,電 正しく使用 そこで本讃 | | | れを制御することで、あらゆる電気機器の制御が可能になるだけでなく、遠方と情報のやり取りをしたり、 律的な判断をさせたりすることが可能になりました。 半から現在に至るまでの工学的進歩には、電子工学の発展が大きく関わっています。 電子工学の成果であるトランジスタやLED等の素子は、従来の機械的スイッチや電球と違った性質があり、 用するには原理を踏まえた知識が必要です。 講義では、初めて電子工学を学ぶ人を想定し、電子の振る舞いと電子デバイスについて基礎的な解説を行いま | | | | |
| 四类の准を | カ方・方法 | す. | ************************************ | | | | |
| 注意点 | | 運動の状電界・磁 | 本とり、超日課度を振ります。 態を考える上で、物理の力学の知識があること。 別についての基礎的な知識があること。 は学習単位科目のため、授業の予習・1 | | ては自学自習を心 | ふがけること. | |
| 授業計画 | Į . | 1 | , | | | | |
| | | | 授業内容 | | 週ごとの到達目標 | | |
| | 3rdQ 4thQ | 1週 | 電子工学の概要説明 | | | 義、応用等について理解する。 | |
| | | 2週 | 電磁界中の電子 | | 3. | 振る舞いについて理解し, 計算でき | |
| | | 3週 | 電磁界中の電子 | | 3. | 振る舞いについて理解し,計算でき | |
| | | 4週 | 原子中の電子 | | | 電子の振る舞いを理解している. | |
| | | 5週 | 固体中の電子 | L | エネルギーバンドを利用して, 固体中の電子の振る舞いを理解している. | | |
| 後期 | | 6週 | 固体中の電子 | L | エネルギーバンドを利用して, 固体中の電子の振る舞いを理解している. | | |
| | | 7週 | キャリア密度と電気伝導度 | | キャリア密度と電気伝導度の関係を理解し、計算できる. | | |
| | | 9週 | 中間試験 p-n接合 | l D | -n接合の整流作用 | | |
| | | 10週 | P-II接口 バイポーラトランジスタ | \frac{1}{\sqrt{1}} | できる. 「イポーラトランジスタの動作について, バンド図を | | |
| | | | | | 用いて説明できる。 MOSFETの動作について,断面図を用いて定性的に説 | | |
| | | 11週 | MOSFET 集積回路 | B | 月できる. | 持徴について,定性的に説明できる | |
| | | 13週 | 光半導体素子 | L | ED等の光半導体 | 素子について,動作原理と特徴を定 | |
| | | 1 2) | ルー・ライボリ | <u> </u> | 性的に説明できる | • | |
| | | | L | | | | |
| | | 14週 | 学習のまとめ | | | | |
| | | 14週 15週 16週 | 学習のまとめ | | | | |
| モデル [_] | コアカリギ | 15週 16週 | | | | | |
| | コアカリニ | 15週 16週 | 学習のまとめ | 五六 | | 到達レベル 授業週 | |
| モデル <u>-</u> 分類 評価割合 | | 15週 16週 トュラムの | 学習内容と到達目標 | 西示 | | 到達レベル 授業週 | |

| 総合評価割合 | 80 | 20 | 100 |
|---------|----|----|-----|
| 基礎的能力 | 0 | 0 | 0 |
| 専門的能力 | 80 | 20 | 100 |
| 分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 |